

三安光电股份有限公司

关于签署《项目投资建设合同》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风险提示：

●投资标的名称：公司拟在长沙成立子公司投资建设第三代半导体产业园项目（子公司名称最终将以有权机关核准为准）

●投资金额：公司以现金 160 亿元投资该项目。项目周期较长，每期投资金额尚未明确，待明确后履行信息披露义务。

●特别风险提示：该事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。该项目能否获得当地环保部门审批通过、依法招拍挂取得项目用地及按照合同约定的内容按期执行尚存在不确定性，合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略，经公司董事会研究，公司决定在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链，投资总额 160 亿元，公司在用地各项手续和相关条件齐备后 24 个月内完成一期项目建设并实现投产，48 个月内完成二期项目建设和固定资产投资并实现投产，72 个月内实现达产。公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会于 2020 年 6 月 15 日签署《项目投资建设合同》。

（二）投资行为生效所必需的审批程序

该事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

(三) 该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合同主体的基本情况

甲方：长沙高新技术产业开发区管理委员会

长沙高新技术产业开发区创建于 1988 年，1991 年获批全国首批国家级高新区。长沙高新区位于湘江以西、岳麓山下，总面积达到 140 平方公里，是长株潭国家“两型社会”建设综合配套改革试验区、长株潭国家自主创新示范区和国家级湖南湘江新区“三区”叠加的核心区。长沙高新区依托强大的科技资源和产业创新优势，先后获批国家创新型科技园区、国家海外高层次人才创新创业基地、国家创新人才培养示范基地、国家科技与金融结合试点园区、国家生态工业示范园区、国家高技术产业化基地、新材料产业基地、软件产业基地等 20 多个国家级产业基地。目前，在全国 169 个国家高新区综合排名中，名列第 11 位。在工信部赛迪研究院发布的“中国产业园区竞争力 100 强”排行榜中，位居第 10 位。

乙方：三安光电股份有限公司

三、投资标的基本情况

根据公司发展战略，经公司董事会研究，公司决定在长沙高新技术产业开发区管理委员会园区成立子公司投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代半导体的研发及产业化项目，包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链，投资总额 160 亿元，公司在用地各项手续和相关条件齐备后 24 个月内完成一期项目建设并实现投产，48 个月内完成二期项目建设和固定资产投资并实现投产，72 个月内实现达产。公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会于 2020 年 6 月 15 日签署《项目投资建设合同》。公司设立子公司的名称、经营范围等相关信息最终以有权机关核准为准，公司将在取得设立的子公司营业执照后，履行信息披露义务。

四、合同的主要内容

(一) 投资项目的的基本情况

为落实第三代半导体产业园项目（以下简称“项目”）的具体实施，根据《民法总则》、《合同法》、《物权法》等有关法律法规规定，双方本着平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，订立本合同。

1、项目具体开发建设内容：投资建设包括但不限于碳化硅等化合物第三代

半导体的研发及产业化项目，包括长晶—衬底制作—外延生长—芯片制备—封装产业链，在甲方园区研发、生产及销售 6 吋 SIC 导电衬底、4 吋半绝缘衬底、SIC 二极管外延、SiC MOSFET 外延、SIC 二极管外延芯片、SiC MOSFET 芯片、碳化硅器件封装二极管、碳化硅器件封装 MOSFET，以甲方认可的乙方项目实施主体最终可研报告为准。

2、项目的实施主体：乙方将在甲方辖区成立控股子公司作为项目实施主体，负责项目的投资、建设及运营。

3、项目用地：项目拟用地位于长沙高新技术产业开发区，用地面积约 1,000 亩，土地用途为工业用地，土地使用权年限为 50 年。

4、项目投资建设规模和进度：项目总投资人民币 160 亿元。甲方承诺依法依规给予乙方和项目实施主体各项投资优惠政策和支持，乙方在用地各项手续和相关条件齐备后 24 个月内完成一期项目建设并实现投产，48 个月内完成二期项目建设和固定资产投资并实现投产；72 个月内实现达产。投资时序、固定资产投资强度等事项最终以乙方项目实施主体可研报告为准。

（二）基础设施配套

甲方出让项目用地的基础设施需达到“八通一平”，接至项目用地红线边；甲方负责在项目用地范围内为乙方项目实施主体建设一座 11 万伏变电站（双回路），变电站产权归乙方项目实施主体所有；甲方负责协助乙方项目实施主体依法依规根据实际情况需要，在项目建设用地范围内建设特种气体气源、原材料等配套设施，并负责协助乙方项目实施主体办理相关手续；甲方负责解决项目实施主体按照环保标准所需的各种污染物排放量指标批复。

（三）投资优惠政策

乙方及项目实施主体应按约履行合同，甲方同意给予乙方项目实施主体补助、扶持、补贴等支持资金，包括科技研发专项扶持、生产要素补贴、两高人才补贴、市场拓展等。

（四）违约责任

双方按照公平公正、平等对等原则，履行完成本合同项下责任义务。任何一方违反合同约定义务的，守约方有权要求违约方在合理期限内整改，违约方未在限期内整改或无法整改的，守约方可根据违约程度以及公平对等原则，要求违约方赔偿相应损失，并视情况选择解除合同。

（五）合同生效条件

经双方签字盖章后成立，并于双方有权机构审批通过之日起生效。

合同还就规划及设计、用地要求及退出条件、不可抗力、其他事项等相关事项进行了界定。

五、对外投资对上市公司的影响

公司主要从事III-V族化合物半导体材料的研发与应用，致力于化合物半导体集成电路业务的发展，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。

第三代半导体产业园项目有着广阔的市场需求，现处于发展阶段。本次投资项目符合国家产业政策规划，符合公司产业发展方向和发展战略，有利于提升公司行业地位及核心竞争力。

六、对外投资的风险分析

本次项目投资建设合同事项已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准，审议结果具有不确定性。

该项目能否获得当地环保部门审批通过、依法取得项目用地及按照合同约定的内容按期执行尚存在不确定性，合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会

2020年6月17日